

## Реферат

Випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 22 с., 13 рис., 8 табл., 3 доданки, 8 джерел.

Наведено результати розробки апаратної частини автоматизованої системи по дослідженню електричних властивостей приладів, побудованих на основі структур з тунельно-тонкими діелектриками. Розроблена апаратна частина установки виконує функції по уніфікації протоколу обміну між вимірювальними приладами та ЕОМ. Виготовлена інтерфейсна плата відповідає всім вимогам, які були висунути до апаратної частини системи та буде використана у системі для досліджень структур  $Si/SiO_2/Si$  з товщинами діелектриків від 15 до 75 Å.

Тунельно-тонкі діелектрики, МТДН структура, структури з тонкими діелектриками, вимірювання електричних властивостей, автоматизація, мікроконтролер, інтерфейсна плата.